



AO6604 , AO6604L (绿色产品)
互补增强型场效应晶体管

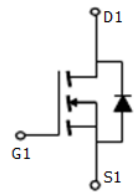
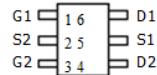
概述

该AO6604采用先进的沟槽技术提供了优秀的研发 $R_{DS(ON)}$ 和低栅极电荷。该互补的MOSFET组成一个高速动力逆变器，适合于多种应用。
AO6604L (绿色产品) 被提供在一个无铅封装。

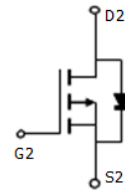
特点

N沟道	P沟道
$V_{DS} (V) = 20V$	-20V
$I_D = 3.4A$	-2.5A
$R_{DS(ON)}$	
< 60mΩ	< 110mΩ ($V_{GS} = 4.5V$)
< 75mΩ	< 140mΩ ($V_{GS} = 2.5V$)
< 100mΩ	< 在200mΩ ($V_{GS} = 1.8V$)

TSOP6
顶视图



N沟道



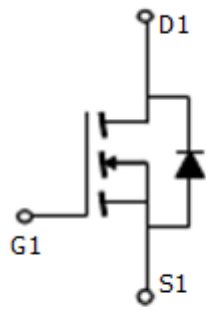
P沟道

绝对最大额定值牛遍 $A = 25^\circ C$ 除非另有说明

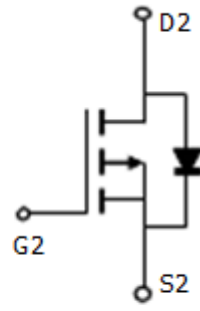
参数	符号	最大的n沟道	最大的p沟道	单位
漏源电压	V_{DS}	20	-20	V
栅源电压	V_{GS}	± 8	± 8	V
连续漏极	I_D	3.4	-2.5	A
当前 ^A				
	$T_A = 70^\circ C$	2.7	-2.0	
漏电流脉冲 ^B	I_{DM}	15	-15	
功耗	P_D	1.15	1.15	W
	$T_A = 70^\circ C$	0.73	0.73	
结温和存储温度范围	$T_J, T_{存储}$	-55到150	-55到150	$^\circ C$

热特性： n沟道和p沟道

参数	符号	典型值	最大	单位
最大结点到环境 ^A	$R_{\theta JA}$	78	110	$^\circ C / W$
最大结点到环境 ^A		106	150	$^\circ C / W$
最大结到铅 ^C	$R_{\theta JA}$	64	80	$^\circ C / W$



N沟道



P沟道

TSOP6
顶视图

